



CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

to the substrate. The control unit includes: a step for supplying the inspection power to the substrate; a step for obtaining information related to the bonding portion temperature after the supply of the inspection power has been stopped; a step for determining an offset temperature of the substrate holding unit on the basis of the information related to the bonding portion temperature; a step for adjusting the temperature of the substrate holding unit on the basis of a control temperature offset by the offset temperature; and a step for supplying the inspection power to the substrate after the temperature of the substrate holding unit has been adjusted, and inspecting the substrate.

(57) 要約: 好適に温度制御を行いながら基板を検査する検査システム及び温度制御方法を提供する。温度調節機構によって温度制御を行いながら、基板を検査する検査システムであって、前記基板を保持する基板保持部と、前記基板の電極部に検査電力を供給する検出部と、制御部と、を備え、前記検出部は、前記基板に設けられた接合部の接合部温度を推定する温度推定部を有し、前記制御部は、前記基板に前記検査電力を供給する工程と、前記検査電力の供給を停止した後、前記接合部温度に関する情報を取得する工程と、前記接合部温度に関する情報に基づいて、前記基板保持部のオフセット温度を決定する工程と、前記オフセット温度でオフセットされた制御温度に基づいて、前記基板保持部の温度を調整する工程と、前記基板保持部の温度が調整された後、前記基板に前記検査電力を供給して、前記基板を検査する工程と、を含む、検査システム。